

第82回半導体・集積回路技術シンポジウム

開催日： 2018年8月30日(木)、31日(金)

会場： 東京理科大学森戸記念館第1フォーラム室

(〒162-0825 新宿区神楽坂 4-2-2)

JR総武線・東京メトロ 飯田橋駅から徒歩7分

主催：電気化学会電子材料委員会 (URL: <http://semicon.electrochem.jp/>)

共催：ECS(米国電気化学会)日本支部

協賛：応用物理学会, エレクトロニクス実装学会, 精密工学会, 電子情報通信学会, 日本表面真空学会

本シンポジウムは、わが国の半導体・集積回路技術分野における特色ある講演会として発足して以来、今回で第82回を迎えることとなりました。LSIの分野では、さらなる微細化の追求に加え2次元半導体材料、3次元構造デバイス、さらにはヘテロ集積化といった多様な選択肢が現れてまいりました。また、エネルギーの有効利用への取り組みが広がる中、パワーデバイス技術もさらなる進展を見せています。これらに焦点を当て、第82回シンポジウムでは、半導体の市場動向・分析、最先端ロジックデバイス、フラッシュメモリ、イメージセンサ、パワーデバイス、ニューロモルフィックデバイス、新材料、新プロセスに関する16件の招待講演を予定しています。また一般講演はポスター発表とし、若手研究者や学生が研究成果を発表する場を設けます。半導体集積回路分野の研究開発や事業に従事する方々に、2日間に亘る活発な討論の場を提供致します。

プログラム(講演発表者)

◇ 第1日 ◇	8月30日(木) 9:55~17:30	◇ 第2日 ◇	8月31日(金) 10:00~17:40
<9:55~10:00>	開会の挨拶	<10:00~10:40>	8. SOI技術を用いた量子イメージングセンサの開発と応用 高エネルギー加速器研究機構 新井康夫
<10:00~10:40>	1. クラウド/IoT技術プラットフォームを構成するシステムデバイスのロードマップ(IRDS 2017)について 日本システムデバイスロードマップ委員会(SDRJ) 林 喜宏	<10:40~11:20>	9. Semiconductor Growth Outlook TSMCジャパン 小野寺誠
<10:40~11:20>	2. 電子機器市場展望とIoT普及の影響 IHS Markit 南川 明	<11:20~12:00>	10. ドライエッチングの基礎からALEまで ラムリサーチ 野尻一男
<11:20~12:00>	3. Logic Technology Scaling to Continue Moore's Law インテル 北野直樹	<12:00~13:10>	屋 食
<12:00~13:10>	屋 食	<13:10~13:50>	11. マイクロ波プラズマ CVD 法によるウェーハスケールでのグラフェン成膜技術 東京エレクトロテクノロジーソリューションズ 井福亮太
<13:10~13:50>	4. 先端SoC技術から2D FETへの潮流 東京工業大 若林 整	<13:50~14:30>	12. 微細 CMOS 向け新コンタクト材料:クラスター気相合成法で形成したWSin (n=12)膜 産業技術総合研究所 岡田直也
<13:50~14:30>	5. Si Power Device の 来し方行く末 (今までとこれから) プロセス技術とウエハ素材の観点から 三菱電機 湊 忠玄	<14:30~15:10>	13. 次世代CMOSイメージセンサーのための分子イオン注入領域における水素拡散挙動の反応速度論解析 SUMCO 奥山亮輔
<14:30~14:45>	休 憩	<15:10~15:25>	休 憩
<14:45~15:25>	6. 酸化ガリウムパワーデバイス技術の開発動向と今後の課題 情報通信研究機構 東脇正高	<15:25~16:05>	14. データの価値判断によるNAND型フラッシュメモリの高信頼化 中央大 竹内 健
<15:25~16:05>	7. ワイドバンドギャップ半導体結晶の欠陥検出の現状と課題 ファインセラミックスセンター 石川由加里	<16:05~16:55>	15. ビッグデータの活用によるメモリ製造革新 東芝メモリ 赤堀浩史
<16:05~16:45>	ポスター・ショートプレゼンテーション(各3分)	<16:55~17:35>	16. AIチップ: ディープラーニングからニューロモルフィック 北海道大 百瀬 啓
<16:45~17:30>	ポスターセッション	<17:35~17:40>	閉会の挨拶
<17:30~19:30>	懇親会		

ポスターセッション(発表者)

- | | |
|---|--|
| P01. マイクロ流路を用いた銅パルスめっきの基礎的観察
東京理科大 川添竜馬 | P06. FinFET 応用に向けた選択成長 GaN チャネルの電気特性
東京工業大 濱田拓也 |
| P02. マイクロフローセルによる銅めっき添加剤の吸着脱離挙動の観察
東京理科大 秋田貴誉 | P07. 湿式 Si エッチング法におけるエッチング形状への PEG 添加の効果
関西大 丹羽良輔 |
| P03. シリコン窒化膜の窒素原子空孔による欠陥準位の第一原理計算
東海大 新里健也 | P08. CuSn 合金ナノニードルを用いた QCM バイオセンサの研究
関西大 若松寛気 |
| P04. N/Si 組成比が異なるシリコン窒化膜の紫外線照射後の伝導電流の変化
東海大 小林大泰 | P09. 高電圧で MONOS 型メモリに捕獲された正孔のチャージセントロイドの決定
東海大 美濃 暢 |
| P05. 金ナノ粒子を触媒としたシリコンおよびシリコンカーバイド上への直接無電解めっき
兵庫県立大 藤居 稜 | P10. 酸化セリウムを用いた MIM キャパシタの過渡応答特性
東京工業大 久恒和也 |

参加登録費 (講演論文集(USBを予定)、懇親会費を含む)

7月31日迄の参加登録: 事前参加申込みを行い、下記参加費を8月20日(火)までにお振込みください。

会員19,000円 会員外21,000円 大学関係10,000円 学生3,000円 (1日のみ 会員13,000円 会員外14,000円)

8月1日~28日の間の参加登録: 事前参加申込みを行い、下記参加費を8月28日(木)までにお振込みください。

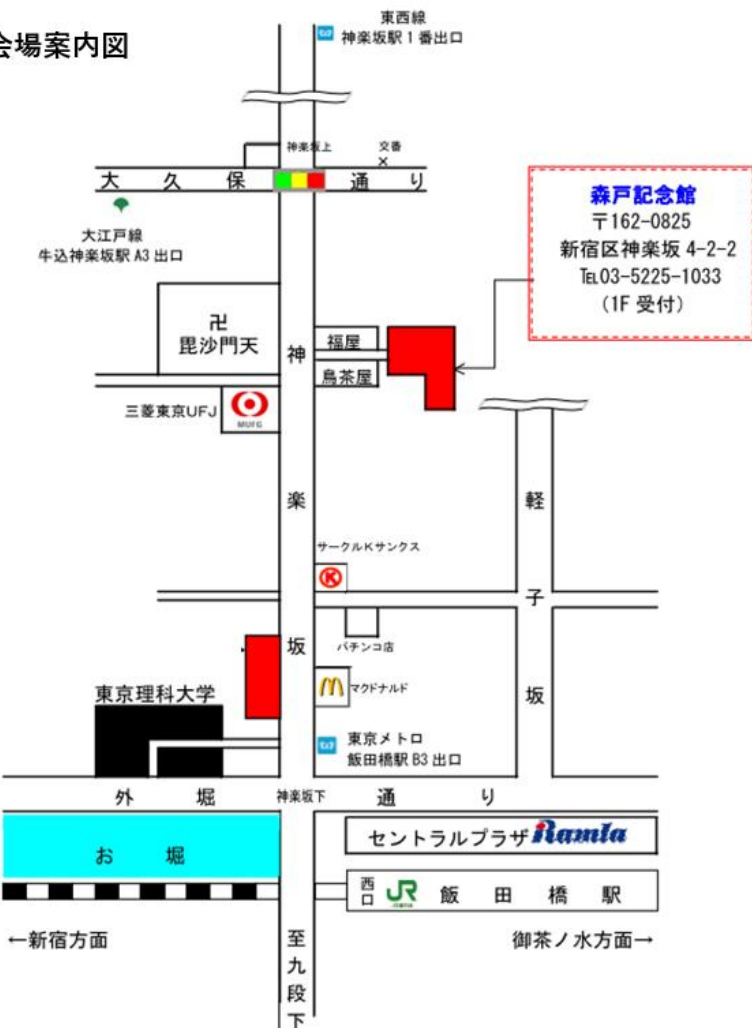
会員22,000円 会員外24,000円 大学関係12,000円 学生3,000円 (1日のみ 会員15,000円 会員外16,000円)

当日参加も可能です。会場の受付で参加登録し、下記参加費を後日お振込みください。

会員22,000円 会員外24,000円 大学関係12,000円 学生3,000円 (1日のみ 会員15,000円 会員外16,000円)

事前参加申込み方法: 申込書式(ホームページに掲載)に従い、電気化学会電子材料委員会事務局まで電子メール又は FAXでお申し込み下さい。

会場案内図



- JR 線「飯田橋」駅西口
- 東京メトロ有楽町線・南北線・東西線「飯田橋」駅 B3 出口
- 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅 A3 出口より
- 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 1 番口

電気化学会電子材料委員会事務局

〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35

関西大学システム理工学部 機械工学科ナノ機能
物理工学研究室内 電気化学会電子材料委員会
事務局

電子メール: semicon@electrochem.jp,

Tel: 06-6368-0881, FAX: 06-6368-0881

振込先: リソナ銀行 千里支店 普通口座0265791

デンシザイリョウインカイ シングウバラ ショウソウ

第 82 回半導体・集積回路技術シンポジウム

プログラム委員会

電子材料委員会委員長: 新宮原正三(関西大)

実行委員長: 小林清輝(東海大)

プログラム委員: 上野和良(芝浦工業大)、恵下 隆
(和歌山大)、近藤英一(山梨大)、筒井一生(東京工
業大)、長井瑞樹(荏原製作所)、長谷川剛(早稲田
大)、早瀬仁則(東京理科大)、前川和義(ルネサスセ
ミコンダクタマニュファクチュアリング)、松川和人
(SUMCO)、三河 巧(パナソニックセミコンダクターソ
リューションズ)、水林 亘(産業技術総合研究所)、
森 義弘(スクリーンセミコンダクターソリューション
ズ)、柳 至(日立製作所)、渡邊 桂(東芝メモリ)

本シンポジウムに関する詳細はホームページにも掲載してい
ます。(http://semicon.electrochem.jp/)